

Germanium PNP Transistor


GF100

15V / 15mA

DATASHEET

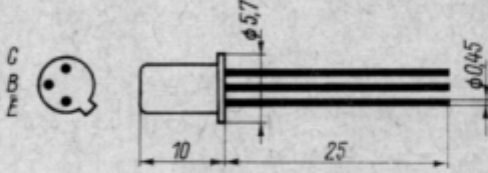
OEM – RFT

Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72



GF 100


Germanium-pnp-Hochfrequenztransistor der Bauform A 3/25-a und A 3/25-b nach TGL 11 811 für ZF-Verstärker in AM-Empfängern.



Masse ca. 0,4 g

Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	= 15 V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	= 10 V
Kollektorstrom	$-I_{CL}$	= 15 mA
Emitterstrom	I_{EL}	= 15 mA
Basisstrom	$-I_{BL}$	= 5 mA
Sperrschichttemperatur	θ_{jL}	= 75 °C
Umgebungstemperatur	θ_{aL}	= -40 °C bis +65 °C
Wärmewiderstand	R_{thja}	≦ 0,5 grad/mW



KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

55

GF 100		RFT electronic		
Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom - $U_{CB} = 6\text{ V}$	- I_{CBO}		1,5 μA	10 μA
Kollektor-Basis-Reststrom - $U_{CB} = 15\text{ V}$	- I_{CBO}		50 μA	500 μA
Kollektor-Emitter-Reststrom - $U_{CE} = 6\text{ V}$	- I_{CEO}		85 μA	600 μA
Kollektor-Emitter-Reststrom - $U_{CE} = 6\text{ V}$	- I_{CES}			25 μA
Emitter-Basis-Reststrom - $U_{EB} = 10\text{ V}$	- I_{EBO}			500 μA
Dynamische Kennwerte				
Grenzfrequenz - $U_{CE} = 6\text{ V}$ - $I_C = 1\text{ mA}$ $f = 3\text{ MHz}$	f_{h21b}	3 MHz	5 MHz	
Kurzschlußstromverstärkung - $U_{CE} = 6\text{ V}$ - $I_C = 2\text{ mA}$ $f = 1\text{ kHz}$	h_{21E}	20		70
Rauschmaß - $U_{CE} = 6\text{ V}$ - $I_C = 0,5\text{ mA}$ $f = 0,5\text{ MHz}$ $R_o = 1\text{ k}\Omega$	F		6 dB	15 dB
Vierpolparameter - $U_{CE} = 6\text{ V}$ - $I_C = 0,5\text{ mA}$ $f = 0,5\text{ MHz}$	g_{11e} C_{11e} g_{12e} C_{12e} y_{21e} g_{22e} C_{22e}		0,5 mS 300 pF 3 μS 7 pF 13 mS 17,5 mS 30 μS 25 pF	1,4 mS 1 nF 7 μS 14 pF 50 μS 50 pF
Bestellbeispiel für einen Transistor		Transistor GF 100		
56		KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER) Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)		